



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

ИНН 7804040077, ОГРН 1027802505279,
ОКПО 02068574

Политехническая ул., 29, Санкт-Петербург, 195251
тел.: +7(812)297 2095, факс: +7(812)552 6080
office@spbstu.ru

21.10.2019

№ 00-Н-6-875

на № _____ от _____

Заместителю председателя
Диссертационного совета
Д 212.243.01 на базе ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского»
д.ф.-м.н., профессору А.В.Скрипалю

410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83

Уважаемый Александр Владимирович!

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» подтверждает свое согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертации Козловского Александра Валерьевича на тему «Фотостимуляция твердотельных сенсорных структур на основе кремния и полиэлектrolитного покрытия», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах».

Подготовка отзыва будет осуществляться Высшей Инженерно-Физической Школой Института Физики, Нанотехнологий и Телекоммуникаций.

Приложение: список основных публикаций сотрудников ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» по теме диссертации соискателя в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет.

Проректор по научной работе
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»




Сергеев В.В.

004220

Список основных публикаций сотрудников ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» по теме диссертации соискателя в рецензируемых научных изданиях за последние пять лет

1. S.A. Kukushkina, A.M. Mizerovd, A.S. Grashchenkoa, A.V. Osipova, E.V. Nikitinad, S.N. Timoshnev, A.D. Bouravlev and M.S. Sobolev Photoelectric Properties of GaN Layers Grown by Plasma-Assisted Molecular-Beam Epitaxy on Si(111) Substrates and SiC/Si(111) Epitaxial Layers // *Semiconductors*, 2019, Vol. 53, No. 2, pp. 180–187;
2. M.P. Teplyakov, O.S. Ken, D.N. Goryachev, O.M. Sreseli Transport and Photosensitivity in Structures: A Composite Layer of Silicon and Gold Nanoparticles on p-Si // *Semiconductors*, 2018, Vol. 52, No. 9, pp. 1193–1197;
3. M.V. Mishin, A.A. Vorobyev, A.S. Kondrateva, E.Y. Koroleva, P.A. Karaseov, P.G. Bepalova, A.L. Shakhmin, A.V. Glukhovskoy, M.C. Wurz and A.V. Filimonov The mechanism of charge carrier generation at the TiO₂-n-Si heterojunction activated by gold nanoparticles // *Semicond. Sci. Technol.*, 2018, Vol. 33, 075014 (9pp);
4. A.S. Grashchenko, N.A. Feoktistov, A.V. Osipov, E.V. Kalinina, and S.A. Kukushkin Photoelectric characteristics of silicon carbide-silicon structures grown by the atomic substitution method in a silicon crystal lattice // *Semiconductors*, 2017, Vol. 51, No. 5, pp. 621–627;
5. I.A. Averin, S.E. Igoshina, A. A. Karmanov, I.A. Pronin, V.A. Moshnikov, and E.I. Terukov Simulation of the Sensor Response of Vacuummeters with Sensitive Elements Based on Multicomponent Oxide Nanomaterials with the Fractal Structure // *Technical Physics*, 2017, Vol. 62, No. 5, pp. 799–806;
6. A.V. Arkhipov, P.G. Gabdullin, S.K. Gordeev, A.M. Zhurkin, and O.E. Kvashenkina Photostimulation of conductivity and electronic properties of field-emission nanocarbon coatings on silicon // *Technical Physics*, 2017, Vol. 62, No. 1, pp. 127–136;
7. I.V. Shtroma, A.D. Bouravleuv, Yu.B. Samsonenko, A.I. Khrebtov, I.P. Soshnikov, R.R. Reznik, G.E. Cirlin, V. Dhaka, A. Perros, and H. Lipsanen Surface passivation of GaAs nanowires by the atomic layer deposition of AlN // *Semiconductors*, 2016, Vol. 50, No. 12, pp. 1619–1621;
8. N.V. Andreeva, A.V. Filimonov, A.I. Rudskoy, G.S. Burkhanov, I.S. Tereshina, G.A. Politova, and I.A. Pelevin A study of nanostructure magnetosolid Nd-Ho-Fe-Co-B materials via atomic force microscopy and magnetic force microscopy // *Physics of the Solid State*, 2016, Vol. 58, No. 9, pp. 1862–1869;
9. V.P. Belik, O.S. Vasyutinskii, A.V. Kukin, M.A. Petrov, R.S. Popov, and E.I. Terukov Crystallization of amorphous hydrogenated silicon (a-Si:H) films under irradiation with femtosecond laser pulses // *Technical Physics Letters*, 2016, Vol. 42, No. 8, pp. 788–791;
10. A.N. Imenkov, E.A. Grebenshchikova, V.A. Shutaev, A.M. Ospennikov, V.V. Sherstnev, and Yu.P. Yakovlev Photovoltage and photocurrent in Pd-oxide-InP structures in a hydrogen medium // *Semiconductors*, 2016, Vol. 50, No. 7, pp. 929–934;
11. A.S. Grashchenko, N.A. Feoktistov, A.V. Osipov, E.V. Kalinina, and S.A. Kukushkin Photoelectric characteristics of silicon carbide-silicon structures grown by the atomic substitution method in a silicon crystal lattice // *Semiconductors*, 2017, Vol. 51, No. 5, pp. 621–627;
12. A.E. Schmidt, A.V. Shvetsova, A.I. Kuklin, D.V. Lebedev, M.A. Surzhik, V.R. Sergeev, and V.V. Isaev-Ivanov Small-angle scattering study of *Aspergillus awamori* glycoprotein glucoamylase // *Crystallography Reports*, 2016, Vol. 61, No. 1, pp. 149–152;
13. N Andreeva, M Tomkovich, Alexander Naberezhnov, Bernard Nacke, Alexey Filimonov, O Alekseeva, P Vanina, Viktor Nizhankovskii SEM and AFM studies of two-phase magnetic alkali borosilicate glasses // *The Scientific World Journal*, 2017, Vol. 2017, 9078152 (9 pp.)
14. T Vergentev, A. Banshchikov, A. Filimonov, E. Koroleva, N. Sokolov, M. C. Wurz. Longitudinal conductivity of LaF₃/SrF₂ multilayer heterostructures //, 2016, Vol. 17, Iss. 1, P. 799-806;
15. В.Б. Бондаренко, А.В. Филимонов Хаотический потенциал на поверхности компенсированного полупроводника в условиях самоорганизации электрически активных дефектов // *Физика и техника полупроводников*, 2015, том 49, вып. 9. С. 1223-1226.